

Publikačný seminár

R. Stoklas:

„Influence of oxygen-plasma treatment on AlGaN/GaN metal-oxide-semiconductor heterostructure field-effect transistors with HfO₂ by atomic layer deposition: leakage current and sensivity of states reduction“

Semiconductor Science and Technology

Čas: 24. február 2017 o 10:00 hod.

Miesto: veľká zasadačka EIÚ SAV, miestnosť 101